

2005 年 6 月 23 日

80nm プロセス、2G ビット DDR2 SDRAM 開発完了

- 業界最先端プロセスにより、大容量 2G ビット DDR2 製品を開発 -



エルピーダメモリ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：坂本幸雄 以下、エルピーダ）は、このたび、世界最先端 80nm プロセスの量産に向けた開発を完了するとともに、その 80nm プロセスを用いた世界最大容量 2G ビット DDR2 SDRAM 製品の一次評価を完了、その開発に成功したことを発表いたします。

エルピーダでは、このたび開発を完了した 80nm プロセスより ArF スキャナーを採用いたしました。このことは、さらにプロセスの微細化を進める上での重要なマイルストーンともなります。

この 2G ビット DDR2 SDRAM は、プロセスと回路 / レイアウト設計の最適化により、

- ・高速動作 DDR2-800（800Mbps 動作）品の安定供給。
 - 現在量産している中で最高速である DDR2-667（667Mbps 動作）品に比べ、高速性能を 20% 向上。
- ・システム上の低消費電力化や熱特性改善に貢献する動作電流の低減。
 - 現在量産中の 100nm プロセス 1G ビット品とほぼ同等の電流特性を確認。
- ・標準メモリモジュール（DIMM）に搭載可能なチップサイズの実現。

- 高さ 30.00mm のレジスタード DIMM や、高さ 30.35mm の FB-DIMM へ搭載可能なチップサイズを実現。

などをターゲットとして開発したもので、このたびの一次評価により、以上のターゲットをクリアしていることを確認しております。

エルピーダがいちはやく達成したこの成果は、サーバなどをはじめとする大容量かつ高品質の DRAM を搭載するシステムの高機能 / 高性能化に、大きく貢献するものと確信しております。

エルピーダでは、今回開発を完了した 80nm プロセスおよび 2G ビット DDR2 SDRAM について、本格量産に向けての評価 / 改良を進め、年度内量産開始を目指して積極的に準備を進めてまいります。

以 上

ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。